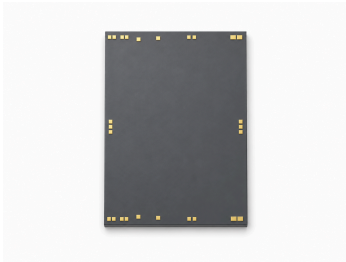


12200–16000 MHz GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이

PSAT: 46 dBm (최솟값) / 46.5 dBm (대표값); 전력 이득: 19 dB (최솟값) / 19.5 dB (대표값); PAE: 33 % (대표값). 다이 치수: 4.2 × 6.02 × 0.1 mm.



RF 특성 · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.0 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
동작 주파수	f	12200	-	16000	12200–16000	MHz
포화 출력 전력	Psat	46	46.5	-	-	dBm
전력 이득	Gp	19	19.5	-	-	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	-	±0.5	-	dB
전력 부가 효율	PAE	-	33	-	-	%
입력 VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-	-

DC 바이어스 및 전류 · TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 전압	Vd	-	28	32	V
게이트 전압	Vg	-3.2	-3	-2.8	V
드레인 정지 전류	Id	-	0.3	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	5	5.5	A
게이트 동적 전류	Igg	-	3	10	mA

한계값

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-5	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	30	dBm
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C
최대 채널 온도	Top	-	-	225	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	$4.2 \times 6.02 \times 0.1$	mm

현재 발행 기록 · 1.3 · 2026-10-27. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.2.

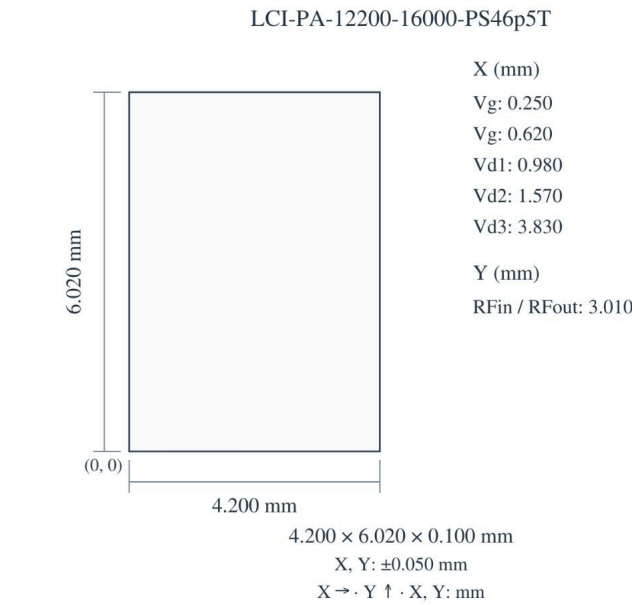
다이 실장과 바이어스 인가 순서

내장 DC 차단: RFin / RFout. 접지로의 DC 경로: RFin → GND. 별도 특성 평가 조건: Vd = +28 V; Vg = -3.0 V; Pin = 27 dBm. 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끝 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

기계 참조 도면의 적용 범위

원자료의 외형 및 명시된 치수 좌표 참조도이며 단위는 mm입니다. 완전한 제조 도면이나 와이어 본딩 도면이 아닙니다.

기구 외형도



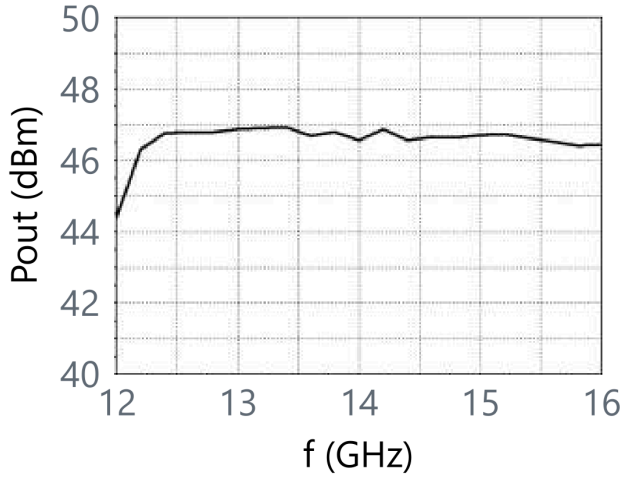
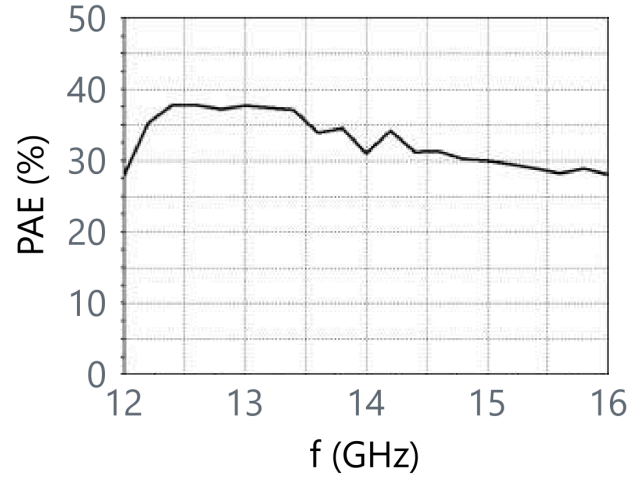
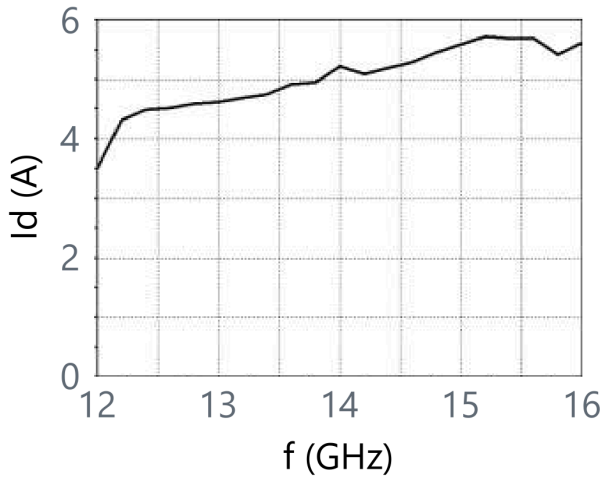
모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

성능 특성 곡선

원본 데이터시트의 그래프입니다. 각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.

포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 동적 전류.

원본 페이지 표기: $V_d = +28V$; $V_g = -3.0V$. 표시된 원본 그래프 본체의 곡선과 격자를 유지하고 외부 좌표축과 배치만 정리했습니다. 측정값 배열이나 가려진 상태를 복원하지 않았습니다. $P_{in} = 27\text{ dBm}$. 조건은 지정된 하위 그래프와 각 그래프의 범례에 해당합니다.



출처

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.